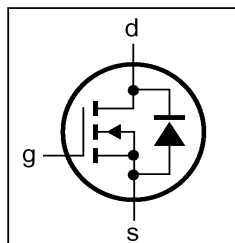


BLV40N20

N-channel Enhancement Mode Power MOSFET

Preliminary
SEP. 2009

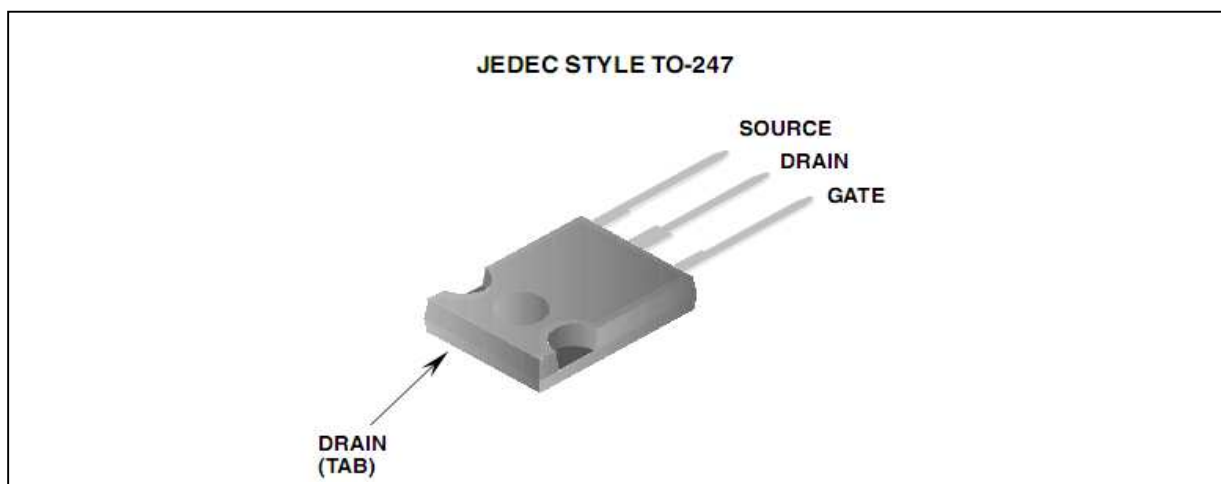
- 低导通电阻
- 低反向传输电容
- 驱动简单



BV_{DSS}	200V
$R_{DS(ON)}$	50mΩ
I_D	40A

产品介绍

200V 40A 大功率 VDMOS 器件，导通电阻小、驱动简单，适合 PDP 驱动电路使用



最大额定参数($T_c=25^{\circ}\text{C}$ 除非另有说明)

符号	参数	极限值	单位
V_{DS}	源漏电压	200	V
V_{GS}	栅源电压	± 30	V
I_D	连续漏极电流	40	A
	脉冲漏极电流 (注释 1)	160	A
I_{DR}	体二极管连续漏极电流	40	A
	体二极管脉冲漏极电流(注释 1)	160	A

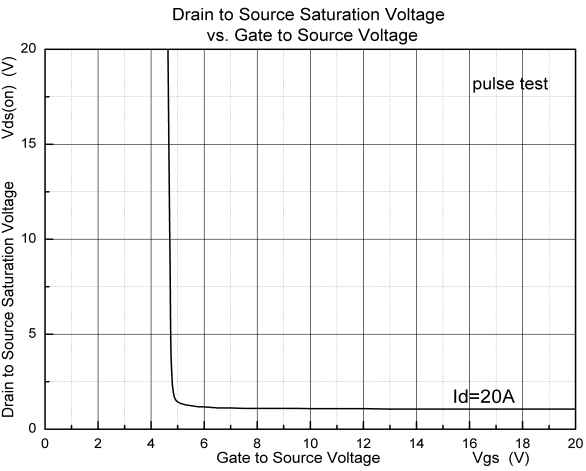
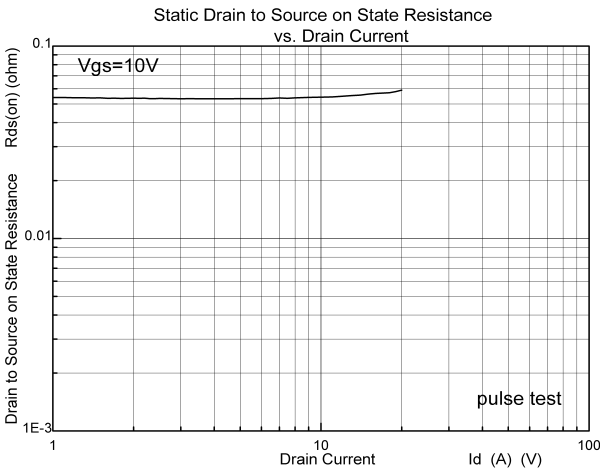
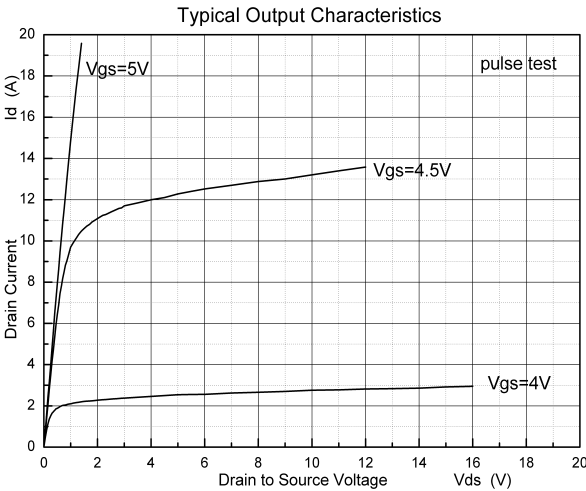
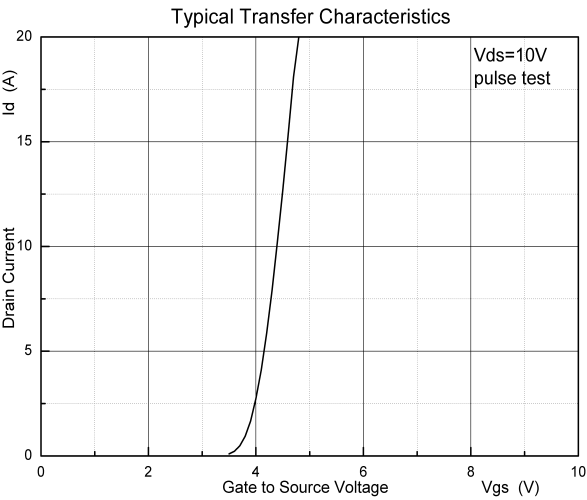
注释: 1. 脉冲宽度 $PW \leq 10\mu\text{s}$, 占空比 $\text{duty cycle} \leq 1\%$

BLV40N20

电学参数 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$ 除非另有说明)

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
BV_{DSS}	源漏击穿电压	$V_{GS}=0V, I_D=1mA$	200	220	-	V
$R_{DS(ON)}$	导通电阻	$V_{GS}=10V, I_D=20A$	-	0.047	0.055	Ω
$V_{GS(th)}$	开启电压	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$	2	3	4	V
I_{DSS}	源极-漏极漏电流	$V_{DS}=200V, V_{GS}=0V$	-	-	10	μA
I_{GSS}	栅极-源极漏电流	$V_{GS}=\pm 20V$	-	-	± 100	nA
C_{iss}	输入电容	$V_{DS}=25V$ $V_{GS}=0V$ $f=1MHz$	-	2300	-	pF
C_{oss}	输出电容		-	450	-	pF
C_{rss}	反向传输电容		-	80	-	pF

典型曲线



封装外形图

TO247

